問題1

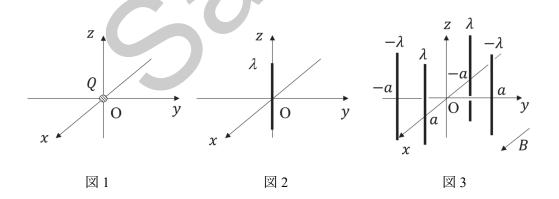
- I. 真空の誘電率を ε_0 とする. 以下の問に答えよ.
- (1) 図 1 のように真空中に設定された原点 0 に点電荷Qをおいた。位置(x, y, z)における電界と電位を求めよ。ただし、無限遠での電位を0とする。
- (2) 図1の点電荷をz方向に十分に長い線電荷(線電荷密度 λ)におき換えた(図2). 位置(x, y, z)における電界と電位を求めよ. ただし、点(a, 0, 0) (a > 0)での電位を0とする.

次に、図3のように真空中にある直線 $x=\pm a$ 、y=0に線電荷密度 λ 、直線x=0、 $y=\pm a$ に線電荷密度 $-\lambda$ の線電荷がおかれている。ただし、 $\lambda>0$ とする。このとき、z軸近傍における電位分布 $\phi(x,y,z)$ は、原点 O での電位を0とすると近似的に式(i)のように与えられる。

$$\phi(x, y, z) = \frac{\lambda}{\pi \varepsilon_0} \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 - \left(\frac{y}{a} \right)^2 \right]$$
 (i)

また、x方向正の向きに一様な磁界が印加されており、その磁東密度はBである。原点 O の近傍の点 (x, y, z)にある荷電粒子(質量m、電荷q > 0)を考える。荷電粒子の運動に伴う磁界や線電荷への影響は考えなくてよい。

- (3) この荷電粒子が受ける力 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ を求めよ. また、この荷電粒子が満たす運動方程式を求めよ.
- (4) 時刻t=0で、この荷電粒子は原点 O にあり、速度 $v_0=\left(0,\,v_y^0,\,0\right)\left(v_y^0\neq0\right)$ 、加速度 $a_0=\left(0,\,0,\,0\right)$ であった。この荷電粒子がt>0においてz軸近傍に束縛されながら運動するためには、質量mは条件 $m<m_0$ を満たす必要がある。 m_0 を求めよ。



II. 真空の誘電率を ϵ_0 , 透磁率を μ_0 とする. 以下の問に答えよ.

図4のように、電気伝導率 σ の均一な材質からなる半径 α の円柱導体が真空中におかれている。その中心軸をz軸とし、z軸の正の方向に電流Iが一様に流れている。円柱導体はその半径 α に対して十分長いものとする。

- (1) 円柱導体の中心軸から距離rの位置における磁束密度の向きと大きさを求めよ、円柱導体は非磁性で その透磁率は μ_0 とする.
- (2) 円柱導体内の電界の向きと大きさを求めよ. また、この円柱導体で単位長さ単位時間あたりに発生するジュール熱を求めよ.
- (3) 円柱導体表面でのポインティングベクトルの向きと大きさを求めよ。また、単位長さ単位時間あたりに円柱導体の表面を通して出入りする電磁界のエネルギーを求めよ。ただし、位置rにおける電界と磁界をE(r)、H(r)としたとき、ポインティングベクトルS(r)は $S(r) = E(r) \times H(r)$ で表される。

真空中におかれた半径bの円形電極を間隔dで対向させた平行平板コンデンサに電荷 Q_0 が蓄積されている。このコンデンサに,スイッチを介して電気抵抗Rを接続する(図 5)。時刻t=0においてスイッチを閉じ放電を開始した。時刻tにおいてコンデンサに蓄えられている電荷をQ(t)とする。bはdに比べて十分大きく,コンデンサの端での効果は無視できるものとする。

- (4) このコンデンサの静電容量Cと放電前に蓄えられているエネルギー U_1 を求めよ.
- (5) 時刻tにおけるコンデンサの電極間の電界と中心軸から距離bにおける磁束密度を、Q(t)を用いて表せ、
- (6) ポインティングベクトルを用いて、放電開始後十分時間が経過するまでにコンデンサに出入りした正味の電磁界のエネルギー U_2 を求めよ.

